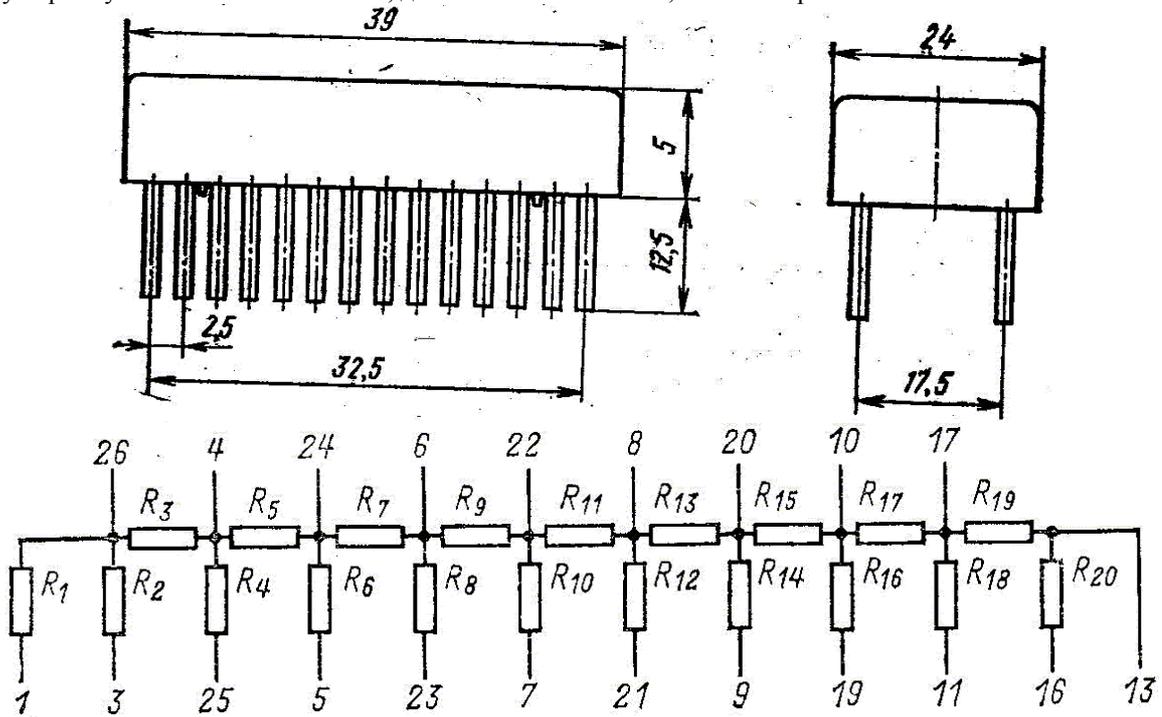


301HP1A — 301HP1M

Тонкопленочная декодирующая резистивная матрица $R=2R$; предназначена для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока.

Корпус прямоугольный 255.АМП.28-1, для печатного монтажа; масса микросхем не более 10 г.



Технические данные

Число разрядов	10
Расчетный номинал R	5 кОм
Допуск	$\pm 10\%$
Коэффициент деления	от $1/1024$ до $1023/1024$ дискретно через $1/1024$
Относительная погрешность коэффициента деления	не более $\pm 0,0135\%$
Температурный коэффициент сопротивления	$< \pm 250 \times 10^{-6} 1/^\circ\text{C}$
Сопротивление изоляции	$> 100 \text{ МОм}$
Время установления выходного напряжения	0,5 мкс

Номиналы резисторов

Позиционное обозначение	Номинал
R1	2R
R2	2R- Δ R
R3	R
R4	2R- Δ R
R5	R
R6	2R- Δ R
R7	R
R8	2R- Δ R
R9	R
R10	2R- Δ R
R11	R
R12	2R- Δ R
R13	R
R14	2R- Δ R
R15	R
R16	2R- Δ R
R17	R
R18	2R- Δ R
R19	R
R20	2R- Δ R

Примечание. С целью снижения погрешности коэффициентов деления при работе с источниками напряжения, имеющими определенное внутреннее сопротивление, разрядные резисторы R2, R4, R6, R8, R10, R12, R14, R16, R18, R20 изготавливаются уменьшенными на значение ΔR , указанное ниже.

Подтип микросхемы	Значение ΔR , Ом	Подтип микросхемы	Значение ΔR , Ом
А	0	Ж	60
Б	10	И	70
В	20	К	80
Г	30	Л	90
Д	40	М	100
Е	50		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	-60...+85°C
Относительная влажность воздуха 98% при температуре +35°C	
Пониженное атмосферное давление	до 667 Па (5 мм рт. ст.)
Напряжение на входе	< 50 В (по некоторым источникам 12,6 В)
Максимальная рассеиваемая мощность	50 мВт
Минимальная наработка	25 000 ч
Срок сохраняемости	25 лет